

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Номер 4, 2017

---

## КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

- Интегрированные алмазные сенсоры с оптическим управлением  
*А. В. Цуканов* 247
- 

## ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

- Влияние особенностей конструкции изолирующей щели открытых “Сэндвич”-структур  $\text{TiN-SiO}_2\text{-W}$  и  $\text{Si-SiO}_2\text{-W}$  на процесс их электроформовки  
*В. М. Мордвинцев, С. Е. Кудрявцев* 266
- Расчёт высокочастотной электропроводности тонкого полупроводникового слоя в случае различных коэффициентов зеркальности его поверхностей  
*И. А. Кузнецова, Д. Н. Романов, О. В. Савенко, А. А. Юшканов* 275
- 

## ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Кинетика травления меди в ВЧ-разряде фреона R-12  
*А. В. Дунаев, Д. Б. Мурин* 284
- Влияние состава смеси на электрофизические параметры и спектры излучения плазмы  $\text{CF}_2\text{Cl}_2/\text{Ar}$  и  $\text{CF}_2\text{Cl}_2/\text{He}$   
*С. А. Пивоваренок* 290
- 

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Оптимизация омических контактов к  $n$ -слоям гетеробиполярных наногетероструктур на основе арсенида галлия  
*В. И. Егоркин, В. Е. Земляков, А. В. Неженцев, В. И. Гармаш* 295
- Разработка методики локального легирования и коррекции проводимости эпитаксиальных слоёв  $\text{PbSnTe}$  путём диффузии индия из поверхностных нанометровых плёнок  
*Д. В. Ищенко, Б. М. Кучумов* 301
- 

## РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕМЕНТАХ И СИСТЕМАХ

- Диффузионная модель ионизационной реакции элементов БИС при воздействии ТЗЧ  
*А. В. Согоян, А. И. Чумаков* 305
- Методика радиационной идентификации предприятия и характеристики технологии изготовления интегральных схем  
*А. В. Согоян, Г. Г. Давыдов, А. С. Артамонов, А. С. Колосова, В. А. Телец, А. Ю. Никифоров, Ю. А. Ожегин, А. С. Каменева, Ю. М. Московская* 313
-